This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-093758

(43) Date of publication of application: 07.04.1995

(51)Int.CI.

G11B 7/08 G11B 7/125 G11B 11/10

(21)Application number: 05-261961

(71)Applicant: SONY CORP

(22)Date of filing:

24.09.1993

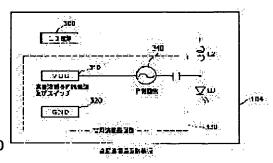
(72)Inventor: TAKANO HIDEKI

(54) OPTICAL PICKUP

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an optical pickup capable of miniaturizing a high frequency superposition circuit substrate.

CONSTITUTION: This pickup is the optical pickup provided with a high frequency superposition circuit for preventing the effect of a return beam from an information recording medium on a laser light source for irradiating a laser beam on the information recording medium. The high frequency superposition circuit 330 is provided with a terminal 300 for the power source of the laser light source LD, the terminal 310 for a high frequency superposition circuit power source sharing a high frequency superposition switch and the terminal 320 for the ground.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.09.2000

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平7-93758

(43)公開日 平成7年(1995)4月7日

技術表示箇所

(51) Int.Cl.⁶

識別記号 庁内整理番号

G11B 7/08

Z 8524-5D

7/125

A 7247-5D

11/10

5 5 1 Z 8935-5D

審査請求 未請求 請求項の数3 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特顏平5-261961

(71)出願人 000002185

ソニー株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)9月24日

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 ▲髙▼野 英樹

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

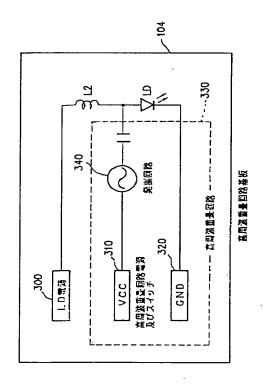
(74)代理人 弁理士 岡▲崎▼ 信太郎 (外1名)

(54) 【発明の名称】 光ピックアップ

(57)【要約】

【目的】 高周波重畳回路基板の小型化を図ることができる光ピックアップを提供すること。

【構成】 情報記録媒体にレーザ光を照射するためのレーザ光源に対する上記情報記録媒体からの戻り光の影響を防ぐために高周波重畳回路を備える光ピックアップにおいて、上記高周波重畳回路330は、上記レーザ光源LDの電源用の端子300と、高周波重畳スイッチを兼ねる高周波重畳回路電源用の端子310と、グランド用の端子320と、を備える光ピックアップ。



10

【特許請求の範囲】

【請求項1】 情報記録媒体にレーザ光を照射するためのレーザ光源に対する上記情報記録媒体からの戻り光の影響を防ぐために高周波重畳回路を備える光ピックアップにおいて、

上記高周波重畳回路は、上記レーザ光源の電源用の端子 と、高周波重畳スイッチを兼ねる高周波重畳回路電源用 の端子と、グランド用の端子と、を備えることを特徴と する光ピックアップ。

【請求項2】 前記高周波重畳回路からの不要輻射は、シールドケースでシールドされている請求項1に記載の 光ピックアップ。

【請求項3】 前記情報記録媒体は、光磁気ディスクである請求項1に記載の光ピックアップ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、たとえばデータストレージ用の光磁気ディスク等のディスク状の情報記録媒体に記録された情報を再生したり、あるいは情報記録媒体に情報を記録するための光ディスク装置に用いられる光 20 ピックアップに関するものである。

[0002]

【従来の技術】光磁気ディスクのような光ディスクに対して用いられる光ピックアップは、情報を記録する時にレーザダイオードから間欠的に光ビームを射出して、所定の変調磁界を印加した光磁気ディスクにこの光ビームを照射することにより、熱磁気記録の手法を適用して野の情報を記録するようになっている。また、この種の光ピックアップは、情報を再生する時に、光磁気ディスクに照射した光ビームの反射光を受光することになってカー効果を利用して記録情報を再生できるようになっている。このために、この種の光ピックアップは、このカンビームを照射したり受光するための光学系スクのような光ビームを照射したりで変光である。このために、この光ピックアップを光磁気ディスクの所望のトラックに情報を記録したりまたはトラックから情報を再生できるようになっている。

【0003】光磁気ディスク(MO、MD:ミニディスク)やAlディスクの情報を再生する時に、レーザダイオードの端面に対して光ディスク側から戻り光があると 40変調されてしまう。このため、光ピックアップは、レーザダイオードの端面への戻り光の影響をキャンセルするために、高周波発振器を備える高周波重畳回路を備えている。

【0004】従来の高周波重畳回路は、図11と図12に示すような構成となっている。すなわち高周波重畳回路電源用の端子(Vcc)1と、レーザダイオード電源用の端子(LDA)2と、高周波重畳スイッチ(回路スイッチ端子、RMS)3、およびグランド(GND)4の合計4端子を備える構成が一般的である。端子(LD 50

・ ドへの順バイアス電流

A) 2は、レーザダイオードへの順バイアス電流を供給する端子である。この高周波重畳回路5は、クランプ型発振器6とカップリングコンデンサC6や、発振器とのアイソレート用のインダクタL2、およびレーザダイオードLD等を備えている。図12の発振器のトランジスタQ1のベースに抵抗分割(R1対R2)して入力されており、電源用の端子(Vcc)1に電圧をかけた状態で、スイッチ(RMS)3に電圧をかけることにより、トランジスタQ1が動作状態になり発振を開始する。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、このような 従来の高周波重畳回路では、上述したように、合計4端 子が必要であるために、回路基板のスペースに制約がで きてしまい、小型化が困難である。この基板高周波重畳 回路基板の小型化が困難であるために、光ピックアップ 自体の小型化が難しくなっている。そこで本発明は上記 課題を解消するためになされたものであり、高周波重畳 回路基板の小型化を図ることができる光ピックアップを 提供することを目的としている。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的は、本発明にあっては、情報記録媒体にレーザ光を照射するためのレーザ光源に対する上記情報記録媒体からの戻り光の影響を防ぐために高周波重畳回路を備える光ピックアップにおいて、上記高周波重畳回路は、上記レーザ光源の電源用の端子と、高周波重畳スイッチを兼ねる高周波重畳回路電源用の端子と、グランド用の端子と、を備える光ピックアップにより、達成される。また本発明は、好ましくは、前記高周波重畳回路からの不要輻射は、シールドケースでシールドされている。また本発明は、好ましくは、前記情報記録媒体は、光磁気ディスクである。

[0007]

【作用】上記構成によれば、レーザ光源の電源用の端子と、高周波重畳スイッチを兼ねる高周波重畳回路電源用の端子と、そしてグランド用の端子の合計3端子ですむ。このため、必要とする基板スペースを小さくできる。

[8000]

【実施例】以下、本発明の好適な実施例を添付図面に基づいて詳細に説明する。尚、以下に述べる実施例は、本発明の好適な具体例であるから、技術的に好ましい種々の限定が付されているが、本発明の範囲は、以下の説明において特に本発明を限定する旨の記載がない限り、これらの態様に限られるものではない。

【0009】図1は本発明の光ピックアップの好ましい実施例を示す斜視図である。この光ピックアップは、好ましくは光磁気ディスク(たとえばMD)に対して情報を記録したりあるいは光磁気ディスクに記録されている情報を読み取るための光学ピックアップである。

【0010】図1において、光ピックアップは、2軸ア

4

クチュエータ10と、スライドベース12と、2軸カバ ー14と、シールドケース16と、フレキシブルプリン ト基板18と、光学ベース26等を有している。2軸ア クチュエータ10は、対物レンズ20をフォーカス方向 FCS(Z軸方向)とトラッキング方向TRK(X軸方 向) に沿ってそれぞれ移動できるような駆動部 (図示せ ず)を備えている。スライドベース12は、光学ベース 26と一体であり、メインシャフト22に対して軸受け 24を介して支持されており、シーク方向(X軸方向、 R方向) に沿ってベース12を移動をできるようになっ ている。またサブシャフト受け23には図示しないシャ フトに対して移動可能に支持されている。 2 軸カバー1 4は、2軸アクチュエータ10を被覆して保護してい る。フレキシブルプリント基板18は、上述した2軸ア クチュエータ10の駆動部や好ましくはレーザダイオー ド等に対して給電するための給電ラインである。シール ドケース16は、図2に示すような構造となっている。 【0011】図2において、シールドケース16は、カ バーケース30とホルダーケース32を備えている。カ バーケース30はレーザダイオードシールドケースとも いう。ホルダーケース32は、光学ブロックもしくは光 学ベース60に対してネジ62により固定されている。 カバーケース30のダボ(図示せず)はホルダーケース 32のダボ80に対して着脱可能にかみ合せて固定され ている。高周波重畳回路基板104は、ダボ80により 位置決めされている。この高周波重畳回路基板104に 対して、好ましくはハイパワー型のレーザダイオードL Dのピン106が半田付けされている。また、この高周 波重畳回路基板104に対しては、3本の線材 (ピンと もいう) 102a, 102b, 102cの一端が半田付 けされている。

【0012】図3には、高周波重畳回路基板104と、 カバーケース30、およびホルダーケース32が示され ている。高周波重畳回路基板104の3つの端子30 0,310、320に対して、それぞれ線材102a, 102b, 102cの一端が半田付けにより接続されて いる。この端子300、310、320の配列は、図3 と図5に示すような配列にすることができる。しかし図 4 あるいは図6に示すような接続部104a, 104 b、104cの配列にすることももちろん可能である。 【0013】図3に示す質通コンデンザアレイ100 は、たとえば図7に示すような形状となっている。質通 コンデンサアレイ100は、本体100cと、2つの質 通コンデンサ110と120を備えている。そして、貫 通コンデンサアレイ100の本体100cは、3つの穴 130を有している。1つの穴130には、線材102 aが挿入される。また、2つの穴130、130には、 貫通コンデンサ110と120が、それぞれ挿入され る。貫通コンデンサ110、120の外周には、グラン ド用の電極100aが形成されていると共に、内部には 50 電極100bが形成されている。図8に示すように、これら電極100bに対して、それぞれ線材102b.102cが挿入されて、好ましくは半田付けされるようになっている。この貫通コンデンサ110,120の電極100aは、本体100cに対して半田付けされている。これに対して線材102aは、本体100cに対して直接半田付けして固定されている。そして、本体100cは、図2のホルダーケース32は、すなわち貫通コンデンサアレイ100を保持するための貫通コンデンサホルダーとも呼ぶことができる。ただし、線材102b,102cをそれぞれ別々の貫通コンデンサに挿入して、そしてこの貫通コンデンサをホルダーケースに直接取り付けることももちろん可能である。

【0014】図7に示す線材102cは、図9のレーザダイオード電源(LDA)用の端子300に半田付けで接続される端子ピンである。また図3の線材102bは、図9に示す高周波重畳回路電源およびスイッチ(Vcc)用の端子310に半田付けで接続される端子ピンである。さらに図3に示す接続ピン102aは、図9に示すグランド(GND)用の端子320に半田付けで接続される端子ピンである。

【0015】図9と図10は、本発明の光ピックアップ における高周波重畳回路基板104の構成例を示してい る。図9と図10において高周波重畳回路基板104 は、レーザダイオード電源(LD)用の端子300と、 高周波重畳回路330と、アイソレート用のインダクタ L2、および高出力のレーザダイオードLD等から構成 されている。この高周波重畳回路基板104に形成され ている回路は、いわゆる3端子モジュール回路とも呼ば れる。レーザダイオードLDからのレーザ光が光磁気デ ィスクに射出されレーザダイオードLDの端面への戻り 光の影響をキャンセルするための高周波発振器である。 【0016】そして、上述したシールドケースを構成す る図2に示すカバーケース30とホルダーケース32、 および図3に示した貫通コンデンサアレイ100によ り、高周波重畳回路330からの高周波の不要輻射をシ ールドするようになっている。なお、このシールドケー スを構成するカバーケース30とホルダーケース32 40 は、たとえば板金により作ることができる。

【0017】図9と図10において、レーザダイオードは、ハイパワー型のレーザダイオードであり、光磁気ディスク用のレーザ光の発生源である。図9の高周波重畳回路330は、高周波重畳回路電源およびスイッチ用の端子310と、グランド用の端子320および発振回路340等を有している。この高周波重畳回路330の詳細な構成は図10に示している。

【0018】すなわち、図10において高周波重畳回路 330は次のような構成となっている。高周波重畳回路 電源およびスイッチ用の端子310と、グランド用の端

部品の点数の削減をすることができる。 さらに、線材と もいう端子の数が 1 つ減るので、端子のシールドケース に対する半田付けの数を削減することができる。

子320が、コンデンサC2に接続されている。また抵抗R1とR2が直列に接続されており、抵抗R1とR2の間にはトランジスタQ1のベースが接続されている。トランジスタQ1のベースに対してコンデンサC3とC4の各一端が接続されている。コンデンサC3とグランド用の端子320の間にはコイルL1が接続されている。またコンデンサC5は、コンデンサC4とグランド用の端子320の間に接続されている。コイルL3と抵抗R3は、トランジスタQ1のエミッタとグランド用の端子320の間に接続されている。コイルC1は、トラ 10ンジスタQ1のコレクタとグランド320の間に接続されている。コンデンサC6は、トランジスタQ1のエミッタとレーザダイオードLDの間に接続されている。コンデンサC6とグランド用の端子320の間に接続されている。

【0022】以上のようにして、基板の小型化および半田付け等の作業の簡略化が図れることにより、全体としてコストの低減化が図れる。ところで本発明は上記実施例に限定されるものではない。光ディスクは、光磁気ディスクに限らずコンパクトディスク (CD) 等も含む。【0023】

【0019】この図10の回路において、レーザダイオ ードLDに対して順バイアスをかけて、発振器をONす る。高周波重畳回路電源およびスイッチ用の端子310 は、従来と異なり、高周波重畳回路電源(Vcc)と回 路スイッチ端子(RMS)とを兼ねたものであり、高周 20 波重畳回路電源と回路スイッチ端子を接続したものであ る。高周波重畳回路電源およびスイッチ310で電源の ON、OFFを行うことにより、回路のON/OFFを も行うこともできる。すなわち、発振器のトランジスタ Q1のベースに対して、抵抗分割R1対R2で入力され ており、高周波重畳回路電源に電圧をかけると同時に回 路スイッチ端子に電圧をかけることができ、トランジス タQ1が動作状態となって、発振を開始することができ る。この発振器を含む高周波重畳回路は、たとえば光磁 気ディスクの情報の再生時において、レーザダイオード 30 LDに対して戻り光があると変調されてしまうので、レ ーザダイオードLDの端面への戻り光の影響をキャンセ ルするのに使用される。

【0020】このように本発明の実施例においては図9

と図10に示すように、高周波重畳回路基板104にお

いて、3端子、すなわちレーザダイオード電源用の端子

300と、高周波重畳回路電源およびスイッチ用の端子

310、およびグランド用の端子320の、合計3端子

として構成することができるので、次のようなメリット

0 【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、高 周波重畳回路基板の小型化を図ることができ、したがっ て光ピックアップの小型化が可能である。

【0021】従来に比べて、高周波重畳回路基板104のサイズを縮小することができる。これにより光ピックアップの小型化および薄型化を図ることができる。また高周波重畳回路基板のサイズの縮小に伴ない、基板のコストの削減を図ることができる。さらには貫通コンデンサ等を併用することにより、貫通コンデンサやシールドケースを用いることにより、EMI(電磁気障害)対策

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光ピックアップの好ましい実施例を示す斜視図。

【図2】図1におけるシールドケースの内部に配置された高周波重畳回路基板およびその周辺を示す図。

【図3】図2のシールドケースおよび高周波重畳回路基板を示す分解斜視図。

20 【図4】高周波重畳回路基板の線材(端子)の接続部分 を示す図。

【図5】図4に示した高周波重畳回路基板の別の実施例を示す図。

【図6】図4に示した高周波重畳回路基板の別の実施例を示す図。

【図7】高周波重畳回路基板とシールドケースの間に関連して設けられる貫通コンデンサアレイの一例を示す図。

【図8】質通コンデンサの1つを示す図。

【図9】本発明の高周波重畳回路基板の概略を示す回路 図

【図10】図9に示す回路の詳細を示す図。

【図11】従来の高周波重畳回路基板を示す概略図。

【図12】図11の従来の高周波重畳回路基板の詳細を示す図。

【符号の説明】

10 2軸アクチュエータ

16 シールドケース

20 対物レンズ

40 104 高周波重畳回路基板

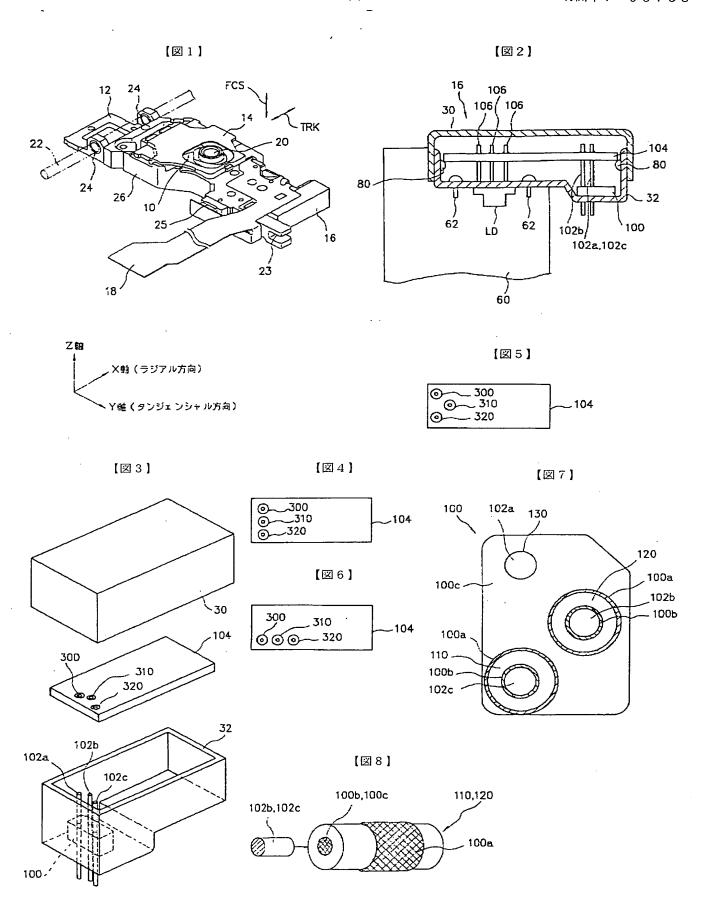
300 レーザダイオード電源 (LD電源) 用の端子

310 高周波重畳回路電源およびスイッチ (Vcc) 用の端子

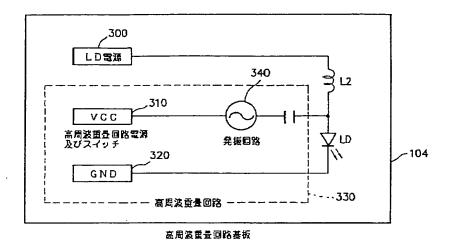
320 グランド (GND) 用の端子

330 高周波重畳回路

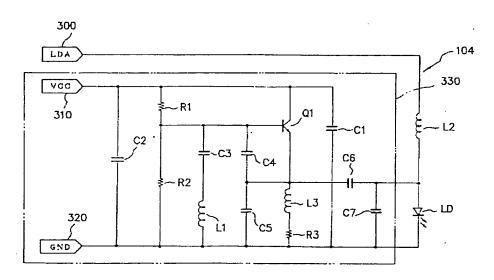
LD レーザダイオード



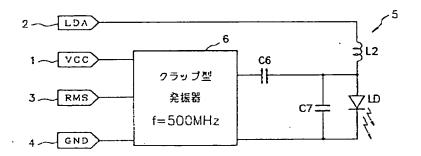
【図9】



[図10]



【図11】



【図12】

